



Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-p-n*. Предназначен для применения в качестве малошумящего усилительного элемента в селекторах, тюнерах и других радиотехнических устройствах. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами, тип корпуса КТ-48. Масса транзистора не более 0,1 г.

**Электрические параметры**

Коэффициент усиления по мощности на частоте 2 ГГц при $U_{кб} = 8 В, I_э = 15 мА$ , не менее .....	8 дБ
Минимальный коэффициент шума на частоте 0,8 ГГц при $U_{кб} = 8 В, I_э = 5 мА$ , не более .....	1,2 дБ
Коэффициент шума на частоте 2 ГГц при $U_{кб} = 8 В, I_э = 15 мА$ , не более .....	3,5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В, I_э = 15 мА$ , не менее:	
$T = +25^{\circ}C$ .....	60
$T = +70^{\circ}C$ .....	60
$T = -45^{\circ}C$ .....	20
Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{кб} = 8 В, I_э = 15 мА$ , типовое значение .....	6,5 ГГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 8 В, f = 100 МГц$ , не более .....	1 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 10 В$ , не более:	
$T = +25^{\circ}C$ .....	0,3 мкА
$T = +70^{\circ}C$ .....	5 мкА
$T = -45^{\circ}C$ .....	0,1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{кб} = 1 В, T = +25^{\circ}C$ , не более .....	0,1 мкА

**Предельные эксплуатационные данные**

Постоянное напряжение коллектор-база .....	20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{об} = 1 кОм$ .....	10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база .....	2,5 В
Постоянный ток коллектора .....	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> :	
$T = -45...+25^{\circ}C$ .....	0,3 Вт
$T = +70^{\circ}C$ .....	0,15 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода .....	+150 $^{\circ}C$
Температура окружающей среды .....	-45 $^{\circ}C...+70^{\circ}C$

<sup>1</sup>При  $T = +25...+70^{\circ}C$  постоянная рассеиваемая мощность коллектора снижается по линейному закону.

Допустимое значение статического потенциала 500 В. Транзисторы должны выдерживать: а) 2-х кратный нагрев до температуры не более +150 $^{\circ}C$  с длительностью одноразового воздействия не более 5 мин.; б) одноразовый плавный нагрев перед пайкой в течение не более 3 мин. до температуры не более +160 $^{\circ}C$ ; в) воздействие тепла во время групповой пайки одноразовым погружением транзисторов в расплавленный припой при температуре не более +265 $^{\circ}C$  в течение (5±1) сек. и одноразовую пайку каждого вывода паяльником при температуре (+260±5) $^{\circ}C$  в течение (2±0,5) сек. Разрешается для очистки печатных плат от флюса после монтажа, влагозащиты и приклейки транзисторов использовать следующие средства: а) спирто-бензоловую смесь в отношении (1:1); б) горячую воду при  $T = +65...+70^{\circ}C$  в течение 5-ти мин.; в) спирто-хладоновую смесь в отношении (1:19).

